

СОДЕРЖАНИЕ

Том 49, номер 3, 2020

ЛИТОГРАФИЯ

Влияние температуры проявления на контраст электронного резиста HSQ

*А. А. Татаринцев, А. В. Шишлянников, К. В. Руденко,
А. Е. Рогожин, А. Е. Иешкин*

163

ПЛАЗМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

О влиянии вида фторуглеродного газа на выходные характеристики
процесса реактивно-ионного травления

А. М. Ефремов, Д. Б. Мурин, К.-Н. Kwon

170

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Роль реадсорбции в формировании вертикальных нанопроволок $A^{III}B^V$
при самокаталитическом росте

А. Г. Настовьяк, А. Г. Усенкова, Н. Л. Шварц, И. Г. Неизвестный

179

Получение электропроводящих структур электрохимическим осаждением меди
на подложках анодированного алюминия при использовании
полифторхалконов в качестве фоторезистного слоя

С. В. Деревяшкин, Е. А. Соболева, В. В. Шелковников

186

Особенности применения реактивного ионного травления кварца
при изготовлении маятниковых узлов Q-flex акселерометров

М. С. Харламов, О. С. Гусева, С. Ф. Коновалов

198

ПРИБОРЫ

Нелокальная динамика электронов в транзисторных гетероструктурах
с донорно-акцепторным легированием

А. Б. Пашковский, А. С. Богданов, В. М. Лукашин, С. И. Новиков

210

Планарный триод для вакуумной микроэлектроники

С. Ш. Рехвиашвили, Д. С. Гаев

226

МОДЕЛИРОВАНИЕ

Моделирование воздействия одиночных ионизирующих частиц на логические
элементы КМОП тройного мажоритарного элемента

Ю. В. Катунин, В. Я. Стенин

230
